



東レリサーチセンター 技術資料 半導体

1. 半導体封止用樹脂の熱硬化挙動解析
2. 実装材料の熱特性評価
3. ナノインデンテーションによる物性マッピング
4. TDSによるSi基板上薄膜のH₂O分析
5. ラマン分光法による先端パワーデバイスの局所温度計測
6. 先端パワーデバイス開発を支援するルミネッセンス分析
7. 実装部品内部の高分子材料のO-PTIRを用いた微小部組成分析
8. 赤外分光法による極薄膜の構造解析
9. 極薄積層絶縁膜の深さ方向官能基量評価
10. ESR法によるSiN膜中の欠陥量の深さ方向分析
11. DLTSを用いたSiO₂/Ga₂N MOSキャパシタの界面および酸化膜中トラップ準位解析
12. 最新XPS装置導入！ ー深さ感度を変えた元素組成・化学状態分析ー
13. マイクロXAFSによるトレンチ構造側壁TiNコート層の化学状態評価
14. TOF-SIMSによるSiC-MOSFETのパッシベーション膜へゲート部の深さ方向分析
15. GD-MSを用いた多種多様な材料の分析
16. SIMSによるウェハ全厚みの不純物分布評価
17. SiC MOSFET トレンチ近傍のNanoSIMS分析
18. プリセッションアシスト4D-STEM法を用いたエピタキシャル磁性薄膜の構造解析
19. EBSD-Wilkinson法を用いたパワーデバイス断面のひずみ解析
20. 電子線照射ダメージを極限まで抑制したAl₂O₃/Ga₂O₃界面のSTEM-EELS評価
21. 加熱 *in-situ* TEM観察とSTEM-EDX分析による金属積層膜の熱挙動把握
22. 半導体デバイス配線部におけるCu-CuボンディングのASTARおよびSTEM-EDX分析
23. 半導体デバイスの広域3D-SEMおよび低ダメージTEM試料作製
24. 半導体用レジスト中の脂環式ポリマーの解析
25. spICP-MSによるレジスト中の金属微粒子分析
26. fsLA-ICP-MSによるSiC基板中の微量元素の三次元イメージング
27. 5G 伝送損失の評価

TORAY

Toray Research Center, Inc.